

2016年(一社)レーザー学会 東京支部セミナー
第27回「若手技術者のためのレーザー応用セミナー」のご案内

日時：2015年7月22日(金) 13:00~17:00 (セミナー終了後に懇親会を開催いたします)

場所：慶應義塾大学 理工学部矢上キャンパス 14棟 B2F マルチメディアルーム
〒223-8522 横浜市港北区日吉3-14-1

交通：<http://www.st.keio.ac.jp/access/index.html>

テーマ：「高機能半導体光源とその応用技術」

セミナーの目的と内容：

半導体光源の代表的デバイスであるLEDとLDは、波長域の拡大や高出力化などの高機能化が着実に進化しており、さらにはそれらの最先端デバイスを用いた新たな用途の開拓などの利用技術の拡張も進んでいます。今回のセミナーでは、最先端の半導体光源とその応用技術にスポットを当て、光源の開発から最新の応用例までを、この分野の第一線でご活躍の先生方にわかりやすく解説していただきます。

参加費：学生無料(テキスト別売)
一般会員(賛助会員を含む) 3,000円(テキスト込)・非会員 5,000円(テキスト込)
*非会員の方は当日入会されると会員扱いとなります。
テキスト販売 500円(学生会員), 1,000円(学生非会員), 2,000円(一般)
懇親会 3,000円

参加申込：当日会場にて受付します(懇親会も同様)

問い合わせ先：伊澤 淳(IHI) E-mail: jun_izawa@ihi.co.jp
TEL 045-759-2819, FAX 045-759-2207

プログラム：(敬称略、講演タイトルは変更となる場合があります)

13:00-13:05	レーザー学会東京支部長挨拶	東海大学	山口 滋
13:05-13:10	企画説明		担当幹事
13:10-14:00	紫外 AlGaIn 半導体レーザーの進展	浜松ホトニクス	吉田 治正
14:00-14:50	無極性・非極性サファイア基板を用いた高効率深紫外 LED の検討	理化学研究所	定 昌史
14:50-15:20			休憩
15:20-16:10	シリコン基板上に集積した横注入薄膜レーザー	NTT 先端集積デバイス研究所	碓塚 孝明
16:10-17:00	マイクロ固体フォトニクスによる小型ジャイアントパルスレーザー	分子科学研究所	平等 拓範
17:20-	懇親会(日吉ファカルティラウンジ)		

詳細と最新情報は「東京支部主催研究会セミナー案内」(レーザー学会 web サイト内)をご確認ください。
http://www.riken.jp/ljsj_tokyo/index.html

会場での企業・団体の宣伝資料設置を受け付け致します(事前受付)。
担当(伊澤)までお問い合わせください。